

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 7 月 3 日(03.07.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/103214 A1

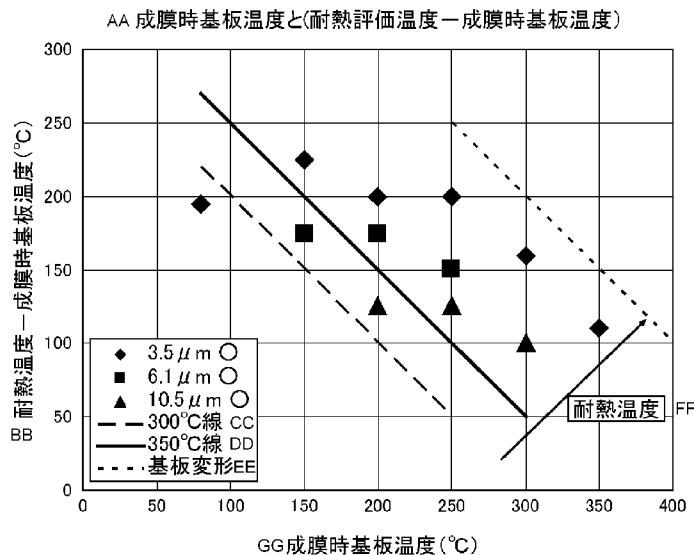
- (51) 国際特許分類:
G11B 5/73 (2006.01) *G11B 5/84* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/007281
- (22) 国際出願日: 2013 年 12 月 11 日(11.12.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-285760 2012 年 12 月 27 日(27.12.2012) JP
- (71) 出願人: 株式会社神戸製鋼所(KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBELCO STEEL, LTD.)) [JP/JP]; 〒6518585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目 2 番 4 号 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: 鈴木 哲雄(SUZUKI, Tetsuo). 藤原 直也(FUJIWARA, Naoya). 平野 貴之(HIRANO, Takayuki).

- (74) 代理人: 小谷 悦司, 外(KOTANI, Etsuji et al.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中之島 2 丁目 2 番 2 号大阪中之島ビル 2 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: ALUMINUM SUBSTRATE FOR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 磁気記録媒体用アルミニウム基板



(57) Abstract: This aluminum substrate for a magnetic recording medium is an aluminum substrate having an SiO₂ film formed thereon, said SiO₂ film having a thickness of 6 μm or more, and the aluminum substrate is characterized in that the SiO₂ film is formed by means of a vapor-phase film forming method by heating the aluminum substrate to 150-370°C.

(57) 要約: 本発明の磁気記録媒体用アルミニウム基板は、厚さ 6 μm 以上の SiO₂ 膜が成膜されたアルミニウム基板であって、前記 SiO₂ 膜は前記アルミニウム基板を 150°C~370°C に加熱して、気相成膜法により成膜されていることを特徴とする。

- AA Substrate temperature during film formation and (heat-resistant evaluation temperature - substrate temperature during film formation)
- BB Heat-resistant temperature - substrate temperature during film formation (°C)
- CC 300°C line
- DD 350°C line
- EE Substrate deformation
- FF Heat-resistant temperature
- GG Substrate temperature during film formation (°C)

WO 2014/103214 A1

WO 2014/103214 A1



(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))